

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN**  
**CHỨC DANH: Phó giáo sư**  
**Mã hồ sơ:.....**



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:  ; Nội dung không đúng thì để trống: )

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Điện tử; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

**A. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên người đăng ký: Lương Duy Mạnh

2. Ngày tháng năm sinh: 26/10/1983; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Triệu Ấu, Quảng Hòa, Cao Bằng

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh):

Học viện Kỹ thuật quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0344996587;

E-mail: manhld@lqdtu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 12,2008 đến tháng, năm 03,2012: Giáo viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Từ tháng, năm 04,2012 đến tháng, năm 03,2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Điện tử-Thông tin Tokyo (UEC), Nhật Bản

Từ tháng, năm 04,2016 đến tháng, năm 04,2017: Thực tập sinh sau tiến sỹ tại Đại học Osaka, Nhật Bản

Từ tháng, năm 04,2017 đến tháng, năm 04,2021: Giáo viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Từ tháng, năm 07,2021 đến tháng, năm 06,2023: Phó Chủ nhiệm bộ môn tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ nhiệm bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Chủ nhiệm bộ môn

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Kỹ thuật quân sự

Địa chỉ cơ quan: Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Học viện Kỹ thuật quân sự

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 22 tháng 06 năm 2005, số văn bằng: QC034170, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 10 tháng 06 năm 2008, số văn bằng: QM007828, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý vô tuyến

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 25 tháng 03 năm 2016, số văn bằng: 203, ngành: Điện-Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Điện tử - Thông tin Tokyo, Nhật Bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Kỹ thuật Quân sự

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện-Điện tử-Tự động hóa

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Kỹ thuật thu phát vô tuyến.

- Công nghệ mạch Terahertz (THz).

- Thu hoạch năng lượng vô tuyến.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 9 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Nhà nước; 2 cấp Cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 41 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giảng viên giỏi mức 2 năm học 2019-2020	Học viện Kỹ thuật quân sự	2020
2	Giảng viên giỏi mức 2 năm học 2020-2021	Học viện Kỹ thuật quân sự	2021
3	Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020	Học viện Kỹ thuật quân sự	2020
4	Giấy khen của Học viện Kỹ thuật Quân sự tặng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020	Học viện Kỹ thuật quân sự	2020
5	Bằng khen của Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự tặng Đã có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn đề tài Nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên năm học 2021-2022	Học viện Kỹ thuật quân sự	2022
6	Đạt giải Ba, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22, năm 2022	Bộ Quốc phòng	2022

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

## B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Là một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, một giảng viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của một nhà giáo. Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ

trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Bản thân luôn phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn, năng lực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, hướng dẫn học viên, sinh viên làm đề án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, nghiên cứu sinh, cũng như hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học.

Luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước, tham dự nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, đảm nhiệm vai trò tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước, tham gia phản biện các bài báo, công trình khoa học trong nước và quốc tế.

Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển các hướng nghiên cứu, chuyên môn học thuật của Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật vô tuyến, Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đôi chiếu với các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, tôi nhận thấy bản thân có đủ điều kiện đề nghị xét công nhận chức danh PGS năm 2023.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 10 năm 0 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức <sup>(*)</sup>
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2017-2018			0.5		270		270/292.5/270
2	2018-2019			3	3	180	105	285/510/270
3	2019-2020				4	375	180	555/745/270
03 năm học cuối								
4	2020-2021			1	5	375	180	555/815/270
5	2021-2022			2	4	210	165	375/647,5/270
6	2022-2023			2		240	60	300/420/270

(\*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

### 3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: Nhật Bản năm 2016

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC, 765 điểm

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Mai Văn Tá		X		X	10/2017 đến 06/2018	Học viện Kỹ thuật quân sự	07/06/2018

2	Nguyễn Văn Thành		X	X		09/2018 đến 05/2019	Học viện Kỹ thuật quân sự	27/5/2019
3	Nguyễn Minh Thành		X	X		09/2018 đến 05/2019	Học viện Kỹ thuật quân sự	27/5/2019
4	Nguyễn Huy Sơn		X	X		09/2018 đến 05/2019	Học viện Kỹ thuật quân sự	27/5/2019
5	Nguyễn Hồng Quyết		X	X		09/2020 đến 07/2021	Học viện Kỹ thuật quân sự	6/7/2021
6	Nguyễn Thái Khoa		X	X		09/2021 đến 06/2022	Học viện Kỹ thuật quân sự	3/6/2022
7	Bùi Duy Linh		X	X		09/2021 đến 06/2022	Học viện Kỹ thuật quân sự	3/6/2022

8	Lê Bá Khánh Duy		X	X		09/2022 đến 06/2023	Học viện Kỹ thuật quân sự	2/6/2023
9	Nguyễn Mạnh Hùng		X	X		09/2022 đến 06/2023	Học viện Kỹ thuật quân sự	2/6/2023

**Ghi chú:** Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS:  
0 ()

**Lưu ý:**

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					

1	Một phương pháp mới để nâng cao hiệu quả làm việc cho các bộ khuếch đại công suất bán dẫn siêu cao tần	CN	102.04-2018.14, cấp Nhà nước	1/12/2018 đến 1/12/2022	16/11/2022; Đạt
2	Nghiên cứu, thiết kế các bộ khuếch đại công suất bán dẫn siêu cao tần hiệu suất cao, độ phi tuyến nhỏ	CN	17.1.041, cấp Cơ sở	10/11/2017 đến 7/12/2018	27/12/2018; Xuất sắc
3	Nghiên cứu, thiết kế bộ tách sóng dải THz thông qua kết hợp điốt tunen cộng hưởng và tinh thể quang tử	CN	18.1.055, cấp Cơ sở	30/11/2018 đến 17/1/2020	21/2/2020; Xuất sắc

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Power Gain Characteristic of Single-Electron Transistors (SETs)	2	Có	2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2013)			302-303	09/2013
2	Power gain improvement for single-electron transistors	2	Có	Japanese Journal of Applied Physic, ISSN: 1347-4065	ISI - SCIE IF: 1.49, Q2		04EJ03, 53, 1-5	02/2014
3	Power Gain Characteristic of Independently	4	Có	IEICE General Conference 2014, ISSN: 1349-144X			C-2-24	04/2014



	Biased HBT Cascode Chip							
4	Comparison of Power Gain Performance between Conventional and Independently Biased HBT Cascode Chips	4	Có	2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2014)			120-121	11/2014
5	Power gain performance enhancement of independently biased heterojunction bipolar transistor cascode chip	4	Có	Japanese Journal of Applied Physic, ISSN: 1347-4065	ISI - SCIE <i>IF: 1.49,</i> <i>Q2</i>	8	54, 4S, 1- 8	04/2015
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
6	Modeling of External Feedback Effect of Resonant Tunneling Diode Oscillator for Terahertz Applications	9	Có	IEICE Technical Report 2016, ISSN: 2432-6380		1	116, 297, 7-12	11/2016
7	Microwave Characteristics of an Independently Biased 3-Stack InGaP/GaAs HBT Configuration	4	Có	IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, ISSN: 1558- 0806	ISI - SCIE <i>IF: 3.605,</i> <i>Q1</i>	13	64, 5, 1140- 1151	12/2016

8	Integration of a Resonant Tunneling Diode Oscillator with a Photonic Crystal Cavity for Highly Stable Terahertz Source	6	Có	The 24th Congress of the International Commission for Optics (ICO-24)		2		08/2017
9	Study of injection locking effect in terahertz resonant tunneling diode oscillators	3	Không	International Conference on Advanced Technologies for Communications 2017 (ATC 2017), ISBN: 978-153862896-6	- Scopus	1	31-34	12/2017
10	External Feedback Effect in Terahertz Resonant Tunneling Diode Oscillators	8	Có	IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, ISSN: 2156342X	ISI - SCIE <i>IF: 3.274, Q1</i>	13	8, 4, 455-464	07/2018
11	Novel Wideband Bandpass Filter using H-shaped DGS	4	Không	International Journal of Electrical and Computer Engineering, ISSN: 2088-8708	Scopus - Scopus <i>IF: 1.938, Q3</i>	3	8, 4, 2021-2028	08/2018
12	Cải thiện hiện tượng cộng hưởng ngẫu nhiên trong cổng đảo đơn điện tử	3	Không	Journal of Military Science and Technology, ISSN: 1859-1043			57 3-10	10/2018
13	Design of An Independently Biased Cascode	4	Có	International Conference on Advanced	- Scopus		129-132	12/2018

	GaN HEMT Microwave Power Amplifier			Technologies for Communications 2018 (ATC 2018), ISSN: 2162-1039				
14	A Novel Independently Biased 3-Stack GaN HEMT Configuration for Efficient Design of Microwave Amplifiers	3	Có	Applied Sciences, MDPI, ISSN: 2076-3417	ISI - SCIE <i>IF: 3.143, Q2</i>	5	9, 7, 1510	04/2019
15	An Independently Biased 3-stack GaN HEMT Configuration for 5G Mobile Networks	3	Có	2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT), ISBN: 978-1-7281-0273-3	- Scopus		1-5	08/2019
16	RF Characteristics of Rectifier Devices for Ambient RF Energy Harvesting	6	Không	2019 International Symposium on Electronics and Smart Devices (ISESD), ISBN: 978-1-7281-2155-7	- Scopus	5	1-4	10/2019
17	Study of a high-responsivity THz detector using resonant tunneling diode and photonic crystals	3	Có	Journal of Military Science and Technology, ISSN: 1859-1043			63A 12-20	11/2019
18	A Novel Circuit Combining a	4	Có	2020 International Conference on	- Scopus		65-67	04/2020

	Dual-band Antenna with a RF Diplexer for Concurrent Dual-band RF Energy Harvesting Applications			Green and Human Information Technology (ICGHIT 2020), ISBN: 978-1-7281-6295-9				
19	Modeling of Single-Electron Transistor in Advanced Design System	3	Không	2020 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2020), ISBN: 978-1-7281-6295-9	- Scopus	2	62-64	04/2020
20	A High-Efficiency X-band Microwave Power Amplifier for AESA Radar System	5	Không	2020 4th International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), ISBN: 978-1-7281-6866-1	- Scopus	1	11-14	09/2020
21	Design of a High-Efficiency GaN High-Electron Mobility Transistor Microwave Power Amplifier	2	Có	Journal of Science and Technology - Technical Universities, ISSN: 2354-1083			147 (2020) 46-50	11/2020
22	A 3-stacked GaN HEMT Power Amplifier	4	Có	International Conference on Industrial Networks	- Scopus		334 95-104	11/2020

	with Independently Biased Technique			and Intelligent Systems (INISCOM 2020), ISBN: 978-3-030-63082-9				
23	An Independently Biased 3-stacked GaN HEMT Power Amplifier for Next-Generation Wireless Communication Systems	2	Có	Radioengineering, ISSN: 1210-2512	ISI - SCIE <i>IF: 0.951, Q3</i>		29, 4, 617-624	12/2020
24	Nghiên cứu thiết kế bộ khuếch đại công suất siêu cao tần hiệu suất cao băng tần 5.8 GHz	3	Có	Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020), ISBN: 978-604-80-5076-4			163-166	12/2020
25	Thiết Kế Mạch Chia Công Suất Băng Rộng 8 Cổng Ra Kiểu Winkinson	3	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020), ISBN: 978-604-80-5076-4			287-290	12/2020
26	Thiết kế bộ lọc thông dải trên ống dẫn sóng dùng cho thông tin vệ tinh băng Ku	3	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2020), ISBN: 978-604-80-5076-4			302-306	12/2020

27	A Concurrent Triple-band RF Energy Harvesting Circuit for IoT Sensor Networks	6	Có	IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, ISSN: 2287-5255	Scopus - Scopus <i>IF</i> : 0.568, <i>Q4</i>		10, 2, 151-159	04/2021
28	Design of a Compact and High-Efficiency 5.8 GHz Microwave Power Amplifier for Wireless Communication Systems	5	Có	International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM 2021), ISBN: 978-3-030-77423-3	- Scopus		379 16-24	05/2021
29	Nghiên cứu thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp sử dụng công nghệ MMIC dùng cho ra đa băng X	3	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2021), ISBN: 978-604-80-5958-3			84-89	12/2021
30	Design of a Ka-band MMIC Low Noise Amplifier for 5G applications	3	Có	8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2021), ISBN: 978-1-6654-1001-4	- Scopus		420-423	02/2022
31	A Cost-Effective 5-W GaN HEMT Power Amplifier for Sub-6-GHz 5G Wireless Communications	3	Có	Mobile Networks and Applications, ISSN: 1572-8153	ISI - SCIE <i>IF</i> : 3.426, <i>Q2</i>	1	27 1757-1767	02/2022

32	Design of a dual-band microwave power amplifier for wireless communications	4	Không	Journal of Military Science and Technology, ISSN: 1859-1043			79 (2022) 10-21	05/2022
33	A Simple Approach for Improving Bandwidth and Isolation of Wilkinson Power Divider	2	Có	Radioengineering, ISSN: 1210-2512	ISI - SCIE <i>IF: 0.951, Q3</i>	1	31, 2, 224-230	06/2022
34	A Reliable High-speed Compact In-memory Matching Circuit for CAM-Application Based on NV-RAM	8	Không	Journal on Information Technologies & Communications, ISSN: 1859-3534			2022, 2, 101-111	09/2022
35	A Compact and Low-cost RF Balun with Improved Bandwidth and Isolation	3	Có	International Conference on Advanced Technologies for Communications 2022 (ATC 2022), ISBN: 978-1-6654-5189-5	- Scopus		210-213	10/2022
36	Nghiên cứu thiết kế bộ khuếch đại phân bố sử dụng công nghệ MMIC	4	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-			20-25	12/2022

				ECIT2022), ISBN: 978-604-80-7468-5				
37	Mạch khuếch đại công suất với cấu trúc đơn giản, hiệu suất cao cho ứng dụng 5G băng tần 6 GHz	2	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022), ISBN: 978-604-80-7468-5			78-83	12/2022
38	Nghiên cứu thiết kế bộ khuếch đại tạp âm thấp băng tần S dùng cho đài ra đa ELM-2288ER	3	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022), ISBN: 978-604-80-7468-5			404-408	12/2022
39	Thiết kế bộ chia công suất băng X trên công nghệ SIW có độ cách ly cao và phối hợp đầu ra tốt	5	Không	Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022), ISBN: 978-604-80-7468-5			287-292	12/2022
40	A low-power charge-based integrate-and-fire circuit for binarized-spiking neural network	8	Không	International Journal of Circuit Theory and Applications, ISSN: 1097-007X	ISI - SCIE <i>IF: 2.378, Q2</i>		2023, 1-11	02/2023
41	A Low-Cost Dual-Band RF Power Amplifier for Wireless Communication Systems	3	Có	Radioengineering, ISSN: 12102512	ISI - SCIE <i>IF: 0.951, Q3</i>		32, 1, 136-141	04/2023



- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 8 ( [7] [10] [14] [23] [27] [31] [33] [41] )

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TĐTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế\*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

*Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.*

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

### **C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023**

**Người đăng ký**

**(Ký và ghi rõ họ tên)**